

LN1VB60**600V 1.2A****特長**

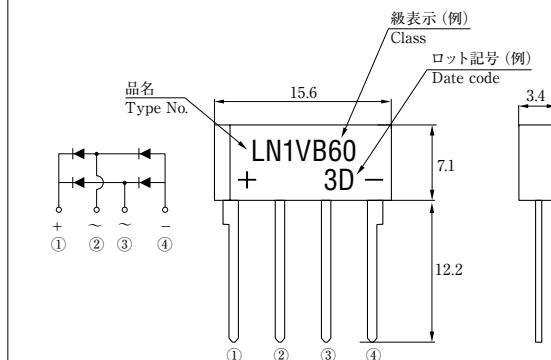
- ・低ノイズ
- ・小型SIPパッケージ

Feature

- Low Noise
- Small-SIP

■外観図 OUTLINE

Package : 1V

Unit : mm
Weight : 1.1g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

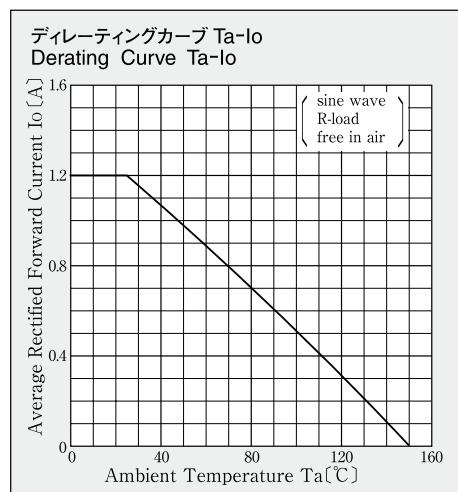
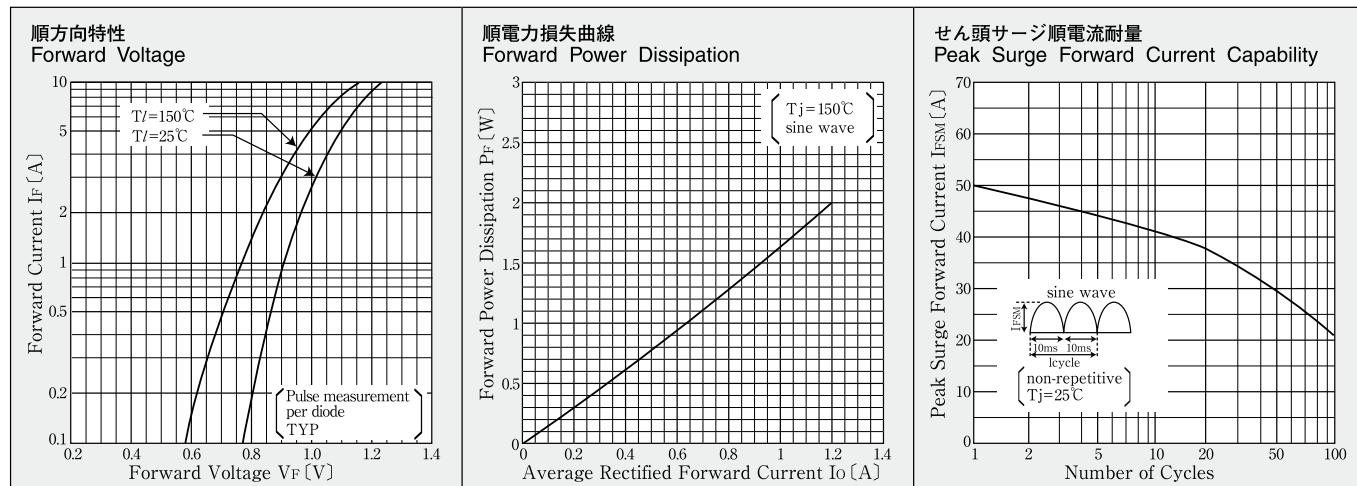
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	LN1VB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a=25^{\circ}\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a=25^{\circ}\text{C}$		1.2	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, $T_j=25^{\circ}\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^{\circ}\text{C}$		50	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, 1素子当たりの規格値 per diode		6	A^2s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=0.6A, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.0	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	IF=0.1A, IR=0.1A, 1素子当たりの規格値 per diode	MAX 5	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jL}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 16	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周間間 Junction to Ambient	MAX 62	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
- Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical is a statistical average of the device's ability.